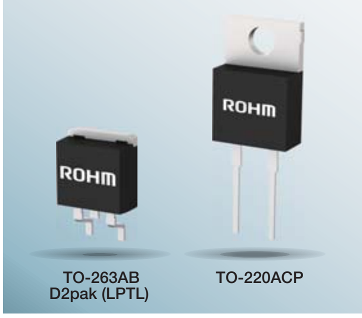
제3세대 SiC 쇼트키 배리어 다이오드

SCS3xxA 시리즈



하이엔드 전원의 PFC 회로에 최적!
Low VF & 높은 서지 전류 내량 SiC-SBD

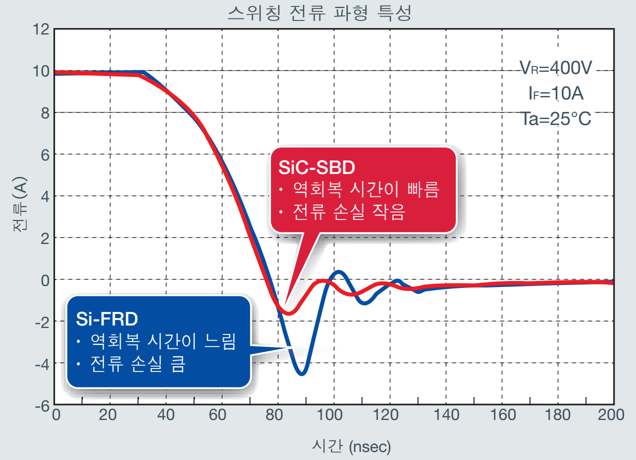
제품 개요

전원기기의 PFC 회로에 사용하는 Si 패스트 리커버리 다이오드 (FRD)를 SiC 쇼트키 배리어 다이오드 (SBD)로 대체하여 사용함으로써, 연속 모드 동작 시 고효율화를 실현할 수 있습니다. 로옴은 예전부터 업계 최소 수준의 Low V_F 특성을 지닌 제2세대 SiC-SBD를 공급해왔습니다. 이번에 높은 서지 전류 내량을 동시에 실현한 SCS3xxA 시리즈 (제3세대 SiC-SBD)를 라인업하여, 한층 더 전원 PFC 용도에 최적인 제품을 공급합니다.

■저손실 SiC-SBD로 고효율 실현

Si-FRD에 비해 SiC-SBD는 역회복 손실이 작아, 기기의 고효율화에 기여합니다.

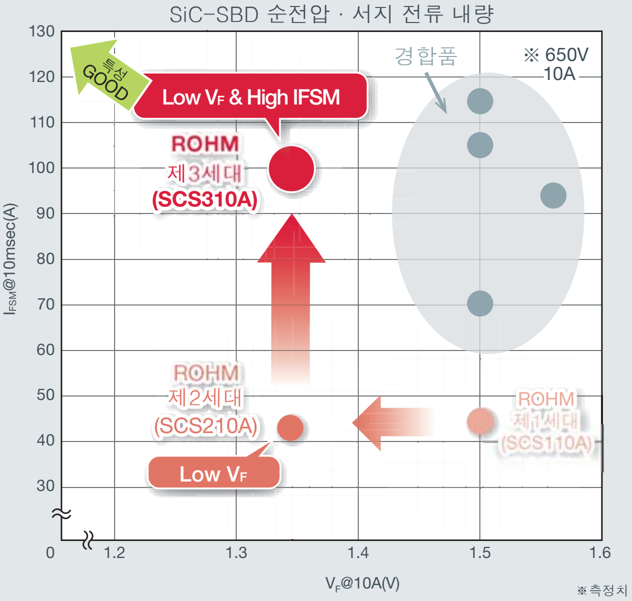
스위칭 전류 파형 특성



■높은 서지 내량으로 전원 PFC 용도에 최적

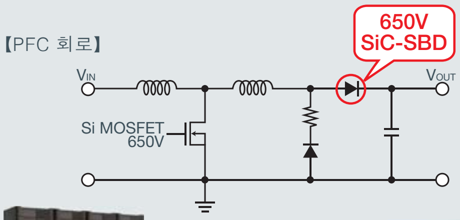
업계 최소 수준의 Low V_F 특성과 더불어, 높은 서지 전류 내량도 실현하여 전원 PFC 용도에 최적입니다.

SiC-SBD 순전압 · 서지 전류 내량



■어플리케이션

컴퓨터, 서버, 에어컨 등 하이엔드 전원 기기 내의 PFC 회로



■라인업 (V_{RM}= 650V)

패키지	순방향 전류 (I_F)				
	2A	4A	6A	8A	10A
TO-220ACP	☆SCS302AP	☆SCS304AP	SCS306AP	SCS308AP	SCS310AP
TO-263AB D2pak(LTPL)	☆SCS302AJ	☆SCS304AJ	☆SCS306AJ	☆SCS308AJ	☆SCS310AJ

☆ :개발중

본 자료에 기재되어 있는 내용은 제품의 소개 자료입니다. 제품 사용 시에는 반드시 별도 사양서를 청구하시어 확인하여 주십시오. 본 자료에 기재되어 있는 정보는 정확성을 위하여 신중히 작성하였으나, 만일 해당 정보의 오류 및 오식에 기인하는 손해가 발생될 경우 로옴은 그 책임을 지지 않습니다. 본 자료에 기재되어 있는 기술정보는 제품의 대표적인 동작 및 응용회로 예 등을 나타낸 것으로, 로옴 또는 타사의 지적재산권 및 기타 모든 권리에 대하여 명시적으로나 묵시적으로도 그 실시 또는 이용을 허락하는 것이 아닙니다. 상기 기술정보의 사용에 기인하는 분쟁이 발생될 경우, 로옴은 그 책임을 지지 않습니다.본 자료에 기재되어 있는 제품 및 기술 중 "외국 외환 및 외국 무역법"에 해당하는 제품 또는 기술을 수출할 경우, 또는 국외에 제공할 경우에는 동일 법에 의거한 허가가 필요합니다.
본 자료의 기재 내용은 2016년 4월 25일 현재의 내용입니다.

ROHM Co.,Ltd.
서울: (02)8182-700
www.rohm.co.kr

Catalog No. 59F6971K 2016.04 ROHM ©